РЕЕСТР ПУБЛИКАЦИЙ

работников АО «НИИМЭ» в 2016г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Дата | Автор (ы)выступающий | Название /тема | Издание/мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2016г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Горнев Е.С., Игнатов П.В.* | «Конструктивно-технологические решения элементной базы кремниевой высокотемпературной микроэлектроники» | Журнал «Наноиндустрия» № 6, 2016 (68) стр. 86-94(Ссылка есть) |
| 2 | 2016г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Горнев Е.С., Потупчик А.Г., Михайлов А.А.,* *Смирнов А.Н.* | «Особенности работы МОП-транзисторов на основе кремниевых структур при высоких температурах» | Журнал «Наноиндустрия» » № 8, 2016Стр.96-103(Ссылка есть) |
| 3 | 2016г. (+)ВАК | *Бурякова Т.Л., Гущин О.П.,* *Горнев Е.С., Данила А.В., Поляков А.Н.* | «Тримминг фоторезиста как технология усиления разрешения оптической литографии» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника», №1 (161) 2016г., стр. 26-35(Ссылка есть) |
| 4 | 2016г. (+)ВАК | *Бенедиктов А.С.,* *Игнатов П.В.* | «Компьютерное моделирование и экспериментальные исследования функционирования КНИ МОП-транзисторов при высоких температурах» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника», выпуск 1 (161) 2016г., Москва, стр.47-52(перенос доклада с конференции в 2015г.)(Ссылка есть) |
| 5 | 2016г. (+) | *Захаров П.С.* | «Разрушение канала проводимости в элементах резистивной памяти на основе тонких пленок нестехиометрического оксида кремния» | Журнал – «Инженерная физика» № 7, 2016, стр.53-56Ссылка есть |
| 6 | 2016г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Игнатов П.В.* | «Моделирование состояний обеднения радиационно-стойких КНИ МОП-транзисторов» | Сборник докладов на конференции РФФТ ХХVI Международной конференции «Радиационная физика твердого тела», Севастополь, 4-9 июля 2016г., стр.135-143(Ссылка есть) |
| 7 | 2016г. (+)ВАК | *Нидеккер Л.Г.,* *Шмигельский В.Н.,* *Эннс В.И.* | «Проектирование цифровых схем на основе БМК с использованием стандартных элементов» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника», №1 (161), 2016г., стр. 23-25(Ссылка есть) |
| 8 | 2016г. (+)ВАК | *Захаров П.С.* | «Характеристики переключения электрической проводимости в тонких пленках нестехиометрического оксида кремния» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 2 (162), 2016г., стр. 60-64(Ссылка есть) |
| 9 | 2016г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Игнатов П.В.* | «Моделирование состояний полного и частичного обеднения высокотемпературных транзисторов на структурах кремний на изоляторе» | Журнал – «Наноиндустрия» №7 (69) 2016г., стр.102-109(Ссылка есть) |
| 10 | 2016г. (+) | *Захаров П.С.* | «Эффект обратимого переключения электрической проводимости в тонких пленках нестехиометрического оксида кремния» | Тезисы доклада конференции – («Кремний-2016»), стр.105(Ссылка есть) |
| 11 | 2016г. (+) | *Ильин С.А.,* *Кочанов С.К.,* *Ласточкин О.В.,* *Новиков А.А.* | «Методика автоматизированной генерации и анализа базовых конструктивов для проектирования блоков динамической и статической защиты интегральных схем от ЭСР» | Сборник трудов Часть III, – VII Всероссийской НТК «Проблемы разработки перспективных микро-и наноэлектронных систем» (МЭС -2016)стр. 100-105(Ссылка есть) |
| 12 | 2016г. (+)ВАК | *Темирбулатов М.С.,* *Эннс В.И.,* *Бобровский Д.В.* | «Методы повышения стойкости к сбоям счетного триггера» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» №2 (162), 2016г., стр. 77-81(Ссылка есть) |
| 13 | 2016г. (+)ВАК | *Красников Г.Я., Гущин О.П., Кузнецов П.И., Есенкин К.С., Рубинас О.Р., Горнев Е.С., Каширин П.А.,* *Колобова Л.А., Руденко К.В., Мяконьких А.В.* | «Исследование и разработка процессов формирования топологии в толстых полимерных пленках бензоциклобутена (ВСВ)» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» №2 (162), 2016г., стр. 29-38 |
| 14 | 2016г. (+) | *Селецкий А.В.,* *Шелепин Н.А.,* *Смолин А.А., Уланова А.В.* | «Исследование влияния разброса технологических параметров СБИС на стойкость к эффектам накопленной дозы радиации с помощью средств приборно-технологического моделирования» | Сборник научных трудов: VII Всероссийской НТК «Проблемы разработки перспективных микро-и наноэлектронных систем-2016» (МЭС-2016), стр. 178-183(Ссылка есть) |
| 15 | 2016г. (+) | *Андреев Д.А., Копцев Д.А.* | «Интегральный цифровой 6-битный аттенюатор для диапазона 8-12 ГГц» | Сборник научных трудов: VII Всероссийской НТК «Проблемы разработки перспективных микро-и наноэлектронных систем-2016» (МЭС-2016) (Ссылка есть) |
| 16 | 2016г. (+) | *Ефимов А.Г., Копцев Д.А., Кузнецова О.С.* | «Разработка СВЧ фазовращателя на основе технологии КНИ 0,18 мкм» | Сборник научных трудов: VII Всероссийской НТК «Проблемы разработки перспективных микро-и наноэлектронных систем-2016» (МЭС-2016), часть-3, стр.33-37(Ссылка есть)  |
| 17 | 2016г. (+)ВАК | *Баранов Г.В., Миленин А.П., Бакланов М.Р.* | «Изучение влияния шага плазменного травления на шероховатость стенок канала Fin FET в схеме гетероинтеграции» | Журнал; Микроэлектроника,2016, том 45, № 3, стр.197-202 |
| 18 | 2015г. (+) | *O. Orlov, A. Markeev, A. Zenkevych, D. Voronov,* *K. Egorov* | «Resistive random access memory (ReRAM) devices developing based on ALD processes» | Сборник тезисов конференции «International workshop ALD Russia 2015», стр.75-76(Ссылка есть) |
| 19 | 2015г. (+) | *O. Orlov, A. Markeev, A. Zenkevych, R. Izmaylov,* *A. Chernikova* | «Ferroelectric random access memory (FRAM) devices developing based on ALD processes» | Сборник тезисов конференции «International workshop ALD Russia 2015», стр.77-78(Ссылка есть) |
| 20 | 2016г. (+)ВАК | *Ролдугина Ж.И., Нуйкин А.В.* | «Обзор инструментов проектирования топологии аналоговых интегральных схем» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника»№ 3 (163), 2016г., стр. 30-40(Ссылка есть) |
| 21 | 2016г. (+)ВАК | *Бокарев В.П.* | «Кристаллическая структура и адгезионные свойства материалов» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» №2 (162), 2016г., стр. 56-59(Ссылка есть) |
| 22 | 2015г. (+) | *Орлов О.М., Маркеев А.М., Зенкевич А.В., Измайлов Р.А., Воронов Д.Д., Егоров К.В., Черникова А.Г.* | «Исследование и разработка элементов энергонезависимой памяти ReRAM, FRAM на основе использования процессов АLD» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.270-272(Ссылка есть) |
| 23 | 2016г. (+)ВАК | *Нуйкин А.В., Кравцов А.С.* | «Разработка и внедрение кристаллов для смарт-карт на российском и международном рынках на основе решений АО «НИИМЭ» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника», №1 (161), стр. 4-8(Ссылка есть) |
| 24 | 2016г. (+)ВАК | *Красников Г.Я.,* *Кирюшина И.В., Егоров А.А.,* *Ранчин С.О., Горнев Е.С.* | «Проблема переосаждения кобальта при формировании спейсера» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника», №1 (161), стр. 36-41(Ссылки нет) |
| 25 | 2016г. (+)ВАК | *Красников Г.Я., Зайцев Н.А., Бокарев В.П.,**Плотников Ю.И.,* | «Физико-технологические особенности формирования сегнетоэлектрической пленки для ячейки запоминающих устройств» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника», №1 (161), стр. 42-46(Ссылки нет) |
| 26 | 2016г. (+) | *Шелепин Н,А.* | «Смарт-карты на основе отечественных микросхем. Разработка, производство, применение» | Пленарный доклад на форуме «Микроэлектроника-2016», стр.18-22 |
| 27 | 2016г. (+) | *Ильин С.А., Кочанов С.К., Ласточкин О.В.,* *Новиков А.А.* | «Методика проектирования и верификации библиотек стандартных цифровых элементов и элементов ввода-вывода»  | Сборник Тезисов Международного форума «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г. стр. 312-316(Ссылка есть) |
| 28 | 2016г. (+) | *Ильин С.А., Кочанов С.К., Ласточкин О.В.,* *Новиков А.А.* | «Методика разработки заказных буферов ввода-вывода на основе библиотек специализированных цифровых элементов» | Сборник Тезисов Международного форума «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г. стр. 317-321(Ссылка есть) |
| 29 | 2016г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Игнатов П.В.* | «Исследование особенностей функционирования МОП - транзисторов на основе структур КНИ и объемного кремния при температурах >125°С» | Сборник Тезисов Международного форума «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г. стр.203-204(Ссылка есть) |
| 30 | 2016г. (+) | *Кузнецов П.И., Гущин О.П., Красников Г.Я.,* *Рубинас О.Р., Горнев Е.С.,* *Каширин П.А.,* *Колобова Л.А., Руденко К.В., Мяконьких А.В.,* *Есенкин К.С.* | «Формирования топологии в толстых полимерных пленках бензоциклобутена (ВСВ)» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г., с.155(Ссылки нет) |
| 31 | 2016г. (+) | *Гвоздев В.А., Валеев А.С., Кузнецов П.И.*  | «Проблемы возникающие при формировании многоуровневой медной металлизации СБИС и способы их решения» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г., стр.157-158(Ссылка есть) |
| 32 | 2016г. (+) | *Резванов А., Чанг Л., Ватанабе М., Криштаб М., де Марнефф Ж.-Ф., Вердонк П., Армини С., Хакер Н., Бакланов М.Р., Гущин О.П.* | «Пассивация стенок пор low-k диэлектрика выбранными полимерами» | Сборник Тезисов Международного форума «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г. стр.200-203(Ссылка есть) |
| 33 | 2016г. (+) | *Резванов А.А.,* *Матюшкин И.В.,* *Гущин О.П.* | «Клеточно-автоматная модель взаимодействия атомов кислорода с пористым low-k диэлектриком»Cellular-automata model of oxygen plasma impact on porous low-K dielectric | Тезисы доклада на конференцию «ISC MNE-2016,Звенигород, Россия, 3-7 октября 2016г., стр.137(Ссылка есть) |
| 34 | 2016г. (+)ВАК | *Резванов А.А.,* *Матюшкин И.В.,* *Гущин О.П.* | «Клеточно-автоматная модель воздействия О₂ плазмы на интегральные свойства SIOCH low-k диэлектрика» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника»,№ 3 (163), Стр.63-78(Ссылка есть) |
| 35 | 2016г. (+) | *Красников Г.Я.,* *Панасенко П.В.,* *Волосов А.В.,* *Котляров Е.Ю., Тишин А.С.* | «Микроминиатюризация приемопередающих субмодулей см-диапазона» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г. с. 379-384(Ссылки нет) |
| 36 | 2016г. (+) | *Красников Г.Я.,* *Панасенко П.В.,* *Волосов А.В.* | «Гетероинтегрированные многокристальные микромодули на основе кремния для СВЧ применений» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г. с. 404-408(Ссылки нет) |
| 37 | 2016г. (+) | *Андреев Д.А., Атамась Д.А., Копцев Д.А., Ковалева О.С.* | «Библиотека кремниевых КМОП СВЧ элементов и сложно-функциональных блоков для построения приемо-передающих модулей». | Статья в журнал Наноиндустрия № 5 (67), 2016г., стр. 46-57(Ссылка есть) |
| 38 | 2016г. (+) | *Андреев Д.А., Атамась Д.А., Копцев Д.А., Ковалева О.С.* | «Библиотека КМОП СВЧ элементов и блоков» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г., с. 408-411(Ссылка есть) |
| 39 | 2016г. (+) | *Иванов В.В., Медведев К.А.* | «Программный комплекс для автоматизации процесса подготовки управляющей информации для изготовления фотошаблонов»  | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г., стр.292-294(Ссылка есть) |
| 40 | 2016г. (+) | *Баранов Г.В.,* *Ключников А.С.* | «Физические особенности использования Poly-Si затвора в Tri-gate транзисторе» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г., стр. 186-187(Ссылка есть) |
| 41 | 2016г. (+) | *Баранов Г.В.,* *Кульков Д.С., Макеев В.В.* |  «Моделирование конструкций теплоотвода для 3D – сборки различных устройств микроэлектроники» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г., стр.188-190(Ссылка есть) |
| 42 | 2016г. (+) | *Измайлов Р.А., Воронов Д.Д., Орлов О.М.* | «Технологические особенности формирования и перспективные конструкторские решения 3D энергонезависимой памяти» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г., стр.185-186(Ссылка есть) |
| 43 | 2016г. (+) | *Измайлов Р.А., Воронов Д.Д., Орлов О.М.* | «Исследование возможности создания памяти большой емкости с использованием ячейки памяти на основе сегнетоэлектрического переключения» | Тезисы доклада на конференцию «Микроэлектроника-2016», Алушта, 26-30.09.2016г., стр.196-199(Ссылка есть) |
| 44 | 2016г. (+)ВАК | *Селецкий А.В., Шелепин Н.А.* | «Проектирование и разработка элементов КМОП СБИС , предназначенных для функционирования в условиях воздействия космических ионизирующих излучений» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» №2 (162), 2016г., стр. 39-45(Ссылка есть) |
| 45 | 2016г.(+)ВАК | *Красников Г.Я.,* *Бардушкин В.В.,**Силибин М.В.,* *Шиляева Ю.И.,* *Яковлев В.Б.* | «Концентрация напряжений и деформаций в анодном оксиде алюминия с нитевидными порами, заполненными поливинилиденфторидом» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» №2 (162), 2016г., стр. 46-55 (Ссылка есть) |
| 46 | 2016г. (+)ВАК | *Бокарев В.П.,* *Красников Г.Я.* | «Использование ультрафиолетового излучения в технологии микро - и наноэлектроники» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 3 (163), 2016г., стр.58-62 |
| 47 | 2016г. (+)ВАК | *Красников Г.Я.,* *Панасенко П.В.,**Волосов А.В.,* *Котляров Е.Ю.,* *Тишин А.С.* | «Приемопередающий субмодуль Х-диапазона частот» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 3 (163), 2016г., стр.23-29 |
| 48 | 2016г. (+)ВАК | *Красников Г.Я.,* *Панасенко П.В.,**Волосов А.В.,* | «Конструктивно-технологические принципы создания СВЧ элементной базы нового поколения на основе объемных технологий современной кремниевой микроэлектроники» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 3 (163), 2016г., стр.10-22 |
| 49 | 2016г. (+) | *Орлов С.Н., Горнев Е.С., Ключников А.С., Тимошенков В.П.,* *Гущин О.П.,* *Бобовников П.Г.* | «Конструкция и моделирование работы транзистора GAA FET с монокристаллическим кремниевым каналом (Design and modeling of GAA FET with a monocrystalline silicon channel) | Тезисы доклада международной конференции «Микро- и наноэлектроника-2016» (ICMNE-2016), 3-7 октября 2016г., Звенигород, Моск.обл., стр. 176(Ссылка есть) |
| 50 | 2016г. (+) | *Андреев Д.А., Копцев Д.А., Ковалева О.С.* | «Сверхвысокочастотные характеристики транзисторов, изготовленных по технологии кремний на изоляторе с длиной канала 180 нанометров» | Статья в научный журнал «Наноиндустрия» №7,2016г, стр.94(Ссылка есть) |
| 51 | 2016г. (+) | *Тишин А.С., Котляров Е.Ю.* | «Малогабаритный приемопередающий субмодуль х-диапазона» | Сборник материалов конференции «Минцевские чтения»(Ссылка есть) |
| 52 | 2016г. (+) | *Резванов А, Чанг Л.,* *Ж.-Ф. де Марнефф, Криштаб М., Хакер Н.,* *Чанг Л., Бакланов М.Р.* | «Исследование уменьшения деградации Low-k диэлектрика путем селективного осаждения защитного полимера на стенки пор» | Тезисы доклада 59 научной конференции МФТИ 21-26 ноября 2016г. (Ссылка есть) |
| 53 | 2016г. (+) | *A.Rezvanov, О.P.Gutshin, A.Miakonkikh, A.Vishnevskiy,* *K. Rudenko, M. Baklanov*  | «Cryogenic etching of porous low-k dielectrics in CF3Br plasma» | Тезисы доклада на конференцию MAM-2016, 20-23 марта, Брюссель, стр.53-54(Ссылка есть) |
| 54 | 2016г. (+) | *Горнев Е.С.* | «Национальные особенности импортозамещения электронной компонентной базы или проблемы унификации ЭКБ» | Журнал «Эксперт+», 2016г, стр. 33-46 |
| 55 | 2016г. (+) | *A.Rezvanov, I.V. Matyushkin, O.P. Gutshin, E.S. Gornev* | «Cellular – automata model of oxygen plasma impact on porous low-k dielectrics» | Доклад Proceedings of SPIE The International Conference on Micro- and Nano-Electronics 2016 02.10.2016 - 07.10.2016, 102241X, pp.1-10 (Ссылка есть) |
| 56 | 2016г. (+) | *Исламов Д.Р.,* *Черникова А.Г.,* *Козодаев М.Г.,* *Маркеев А.М., Перевалов Т.В., Гриценко В.А.,* *Орлов О.М., Красников Г.Я.* | «Механизм транспорта токов утечки в пленках аморфных и сегнетоэлектрических пленках Hf 0,5Zr 0,5 O2» | XI Конференция и X Школа молодых ученых «КРЕМНИЙ-2016» 12-15 сентября 2016 г., Новосибирск,Тезисы докладов, стр.54(Ссылки нет) |
| 57 | 2016г. (+) | *Орлов О.М., Красников Г.Я., Измайлов Р.А., Воронов Д.Д., Горнев Е.С.* | «Разработка энергонезависимой памяти FRAM на основе использования многокомпонентного оксида Hf0,5Zr0,5O2» | XI Конференция и X Школа молодых ученых «КРЕМНИЙ-2016» 12-15 сентября 2016 г., Новосибирск,Тезисы докладов, стр.98(Ссылка есть) |
| 58 | 2016г. (+) | *Исламов Д.Р.,* *Гриценко В.А.,* *Перевалов Т.В.,* *Орлов О.М., Красников Г.Я.* | «Механизм транспорта электрически-индуцированных токов утечки и природа электронных ловушек в термическом оксиде кремния» | XI Конференция и X Школа молодых ученых «КРЕМНИЙ-2016» 12-15 сентября 2016 г., Новосибирск,Тезисы докладов, стр.110(Ссылки нет) |
| 59 | 2016г. (+) | *Орлов О.М* | «Физические и конструктивно-технологические особенности перспективных транзисторных структур в кремниевой микроэлектронике» | XI Конференция и X Школа молодых ученых «КРЕМНИЙ-2016» 12-15 сентября 2016 г., Новосибирск,Тезисы докладов, стр.175(Ссылка есть) |
| 60 | 2016г. (+) | *Орлов О.М* | «Разработка энергонезависимой памяти FRAM на основе использования процессов ALD»  | XI Конференция и X Школа молодых ученых «КРЕМНИЙ-2016» 12-15 сентября 2016 г., Новосибирск,Тезисы докладов, стр.176(Ссылка есть) |
| 61 | 2016г. (+) | *Четвериков В.А., Итальянцев А.Г.,* *Баранов Г.В.* | «Твердофазный тримминг при формировании структур кремниевой микроэлектроники» | Тезисы доклада 59 научной конференции МФТИ 21-26 ноября 2016г. (Ссылка есть) |
| 62 | 2016г. (+) | *Итальянцев А.Г.,**Константинов В.С.* | «Размерные эффекты поляризации в тонких пленках легированного оксида гафния» | Тезисы доклада 59 научной конференции МФТИ 21-26 ноября 2016г.(Ссылка есть) |
| 63 | 2016г. (+)ВАК | *Зайцев С.А., Кузнецова Е.В., Гущин О.П., Красников Г.Я., Горнев Е.С.* | «Оптимизация процесса электронной литографии для периодических структур методом комбинированной модификации формы и дозы элементов структур»  | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 3 (163), 2016г., стр.53-57 |
| 64 | 2016г. (+)ВАК | *Панышев К.А.,* *Ключников А.С.* | «Эффект радиационно-индуцированной защелки в 90 нм КМОП –технологии в зависимости от угла и места падения тяжелой заряженной частицы» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 3 (163), 2016г., стр.4-9 |
| 65 | 2016г. (+)ВАК | *Колобов А.В., Иванов В.В., Кузовков А.В., Арилин Р.А.* | «Разработка OPC модели для технологии уровня 65 нм  | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 4 (164), 2016г., стр.4-9 |
| 66 | 2016г. (+)ВАК | *Резванов А, Чанг Л.,* *Ж.-Ф. де Марнефф, Криштаб М., Хакер Н.,* *Чанг Л., Бакланов М.Р.* | «Исследование уменьшения деградации Low-k диэлектрика путем селективного осаждения защитного полимера на стенки пор» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 4 (164), 2016г., стр.10-19 |
| 67 | 2016г. (+)ВАК | *Четвериков В.А.,* *Баранов Г.В.,* *Итальянцев А.Г.* | «Твердофазный тримминг при формировании структур кремниевой микроэлектроники» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 4 (164), 2016г., стр.20-24 |
| 68 | 2016г. (+)ВАК | *Бокарев В.П.,* *Красников Г.Я.* | «Анизотропия физико-химических свойств монокристаллических поверхностей» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 4 (164), 2016г., стр.25-30 |
| 69 | 2016г. (+)ВАК | *Жевненко Д.А.,* *Вергелес С. С.,* *Криштоп Т. В.,* *Терешонок Д. В.,* *Горнев Е.С.,* *Криштоп В. Г.* | «Моделирование процессов переноса массы и заряда в планарных электрохимических преобразователях». | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 4 (164), 2016г., стр.31-37 |
| 70 | 2016г. (+)ВАК | *Горнев Е. С.,* *Матюшкин И. В.,* *Вильданов Р. Р.,* *Коробов С. В* | «Асинхронный клеточный автомат, моделирующий абстрактную бимолекулярную реакцию на сфере» | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 4 (164), 2016г., стр.38-56 |
| 71 | 2016г. (+)ВАК | *Красников Г.Я.,* *Бардушкин В.В.,* *Румянцева., Е.Н.,* *Яковлев В.Б.* | «Модель поляризации сегнетокерамики на основе представлений неоднородных сред». | Журнал «Электронная техника. Серия 3.Микроэлектроника» № 4 (164), 2016г., стр.57-61 |
| 72 | 2016г. (+) | *Измайлов Р.А.* | «Перспективы развития современного рынка 3D энергонезависимой памяти» | Тезисы доклада 59 научной конференции МФТИ 21-26 ноября 2016г. (Ссылка есть) |
| 73 | 2016г. (+)ВАК | *Гаврилов С.В.,* *Матюшкин И.В., Стемпковский А.Л.* | «Вычислимость в клеточных автоматах» | Журнал «Искусственный интеллект и принятие решений», 2016, № 1. С. 18-36. |
| 74 | 2016г. (+) | *И. В. Матюшкин,* *Г. Я. Красников,* *Н. В. Черняев, Е. С. Горнев, Н. В. Евстратов.* | «Численное исследование параметрических свойств решений некоторого уравнения типа Штурма–Лиувилля» | Журнал -ТРУДЫ МФТИ. 2016. Том 8, № 4, c.71-92 |
| 75 | 2016г. (+) | *Заплетина М.А.,* *Матюшкин И.В.* | «Применение клеточных автоматов для описания прохождения электрического тока в межсоединениях сверхбольших интегральных схем». |  XVII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию и информационным технологиям. Тезисы докладов. - Новосибирск. - 2016. - С.39. |
| 76 | 2016г. (+) | *Damir R.Islamov,* *Vladimir A. Gritsenko, Timofey V. Perevalov, Oleg M. Orlov, Gennady Ya. Krasnikov* | «The charge transport mechanism and electron trap nature in thermal oxide on silicon» | Журнал - Applied physics letters 109, 052901 (2016) doi: 10. 1063/1.4960156.Стр. 1- 4 |
| 77 | 2016г. (+) | *V. A. Gritsenko,* *T. V. Perevalov, O. M. Orlov,**G. Ya. Krasnikov* | «Nature of traps responsible for the memory effect in silicon nitride» | Журнал - Applied physics letters 109, 062904 (2016) doi: 10. 1063/1.4959830Стр. 1- 4 |
| 78 | 2016г. (+) | *D.R. Islamov, V.A. Gritsenko, T.V. Perevalov, O.M. Orlov, G.Ya. Krasnikov* | Charge transport mechanism of stress induced leakage current in thermal silicon oxide | Журнал ECS Transactions 75(5) 2016, 57-62 |
| 79 | 2016г. (+)ВАК | *Орлов О.М., Маркеев А.М., Зенкевич А.В., Черникова А.Г., Спиридонов М.В., Измайлов Р.А., Горнев Е.С.* | «Исследование характеристик и особенностей изготовления элементов энергонезависимой памяти FRAM, полученных с использованием процессов атомно-слоевого осаждения» | Журнал –Микроэлектроника, 2016, том 45, №4 с.1-9Ссылка есть |
| 80 | 2016г. (+)ВАК | *Орлов О.М., Исламов Д.Р., Черникова А.Г., Козодаев М.Г., Маркеев А.М., Перевалов Т.В., Гриценко В.А., Красников Г.Я.* | «Транспорт заряда в тонких слоях сигнетоэлектрического Hf 0,5Zr 0,5O2» | Журнал –Микроэлектроника, 2016, том 45, №5 с.379-385 |
| 81 | 2016г. (+) | *Damir R.Islamov, V. A. Gritsenko, T. V. Perevalov,* *O. M. Orlov, G.Ya. Krasnikov* | Mechanism of charge transport of stress induced leakage current and trap nature in thermal oxide on silicon | 33 rd International conference on the Physics of Semiconductors, 2016.7.31-2016.8.5 , ICPS 2016, Beijing, China, Mo-P.020, c.86 |
| 82 | 2016г. (+) | *Нагнойный В.А.,* *Баранов Г.В.* | «Формирование электрической изоляции Tri-gate транзистора» | Сборник тезисов 59 конференции МФТИСсылка есть |
| 83 | 2016г. (+)ВАК | *Негров Д.В., Киртаев Р.В., Киселева И.В., Кондратюк Е.В., Маркеев А.М., Шадрин А.В., Зенкевич А.В.,* *Орлов О.М., Горнев Е.С., Красников Г.Я.* | «Интеграция функциональных элементов энергонезависимой памяти топологии 1Т-1R» | Журнал «Микроэлектроника»-2016, т.45, №6, с.421-433 |
| 84 | 2016г. (+)ВАК | *Новиков Ю.Н.,* *Гриценко В.А.,* *Красников Г.Я.,* *Орлов О.М.* | «Флэш память основанная на мультиграфене» | Журнал «Микроэлектроника»-2016, т.45, №1, с.66-71 |
| 85 | 2016г. (+)ВАК | *Авдонин Б.Н., Макушин М.В., Мартынов В.В.,* *Орлов О.М., Стяжкин А.Н., Фомина А.В.* | «Перспективные направления дальнейшего развития отечественной микроэлектроники с учетом зарубежного опыта» | Журнал Радиопромышленность,2016, № 3 вып.1 с.131-142Ссылка есть |